



Fully Automatic Polisher DFP8140/60

非化学式消除表面残余应力

提高薄型晶圆的良率

DFP8140/8160是不再使用研磨液（膏）、化学药品，亦能对晶圆背面进行干式抛光技术的装置。能去除研削程序所产生的表面变质层和残余应力。还能防止晶粒碎片及翘曲、降低晶粒翘曲、增加晶粒的抗折强度、提高良率，同时，能减少对环境的污染。

可与现有的研削机联机运行

DFP8140/8160可与现有的研削机整合联机，利用与DFG8540/8560的联机功能（特殊选配），可以安全地进行设备之间的晶圆传送。



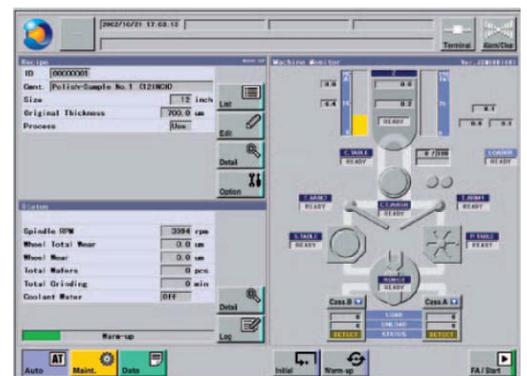
DFP8160

降低环境污染

与湿式蚀刻加工法和CMP加工法不同，干式抛光加工法不需使用化学药品，没有药液处理程序，因此既降低了对环境的污染，又有助于减少用户的运行成本。

操作简便

DFP8140/8160配置了触摸式液晶显示器及图形化的用户接口GUI（Graphical User Interface），提高了操作便利性。而且设备的机械状态和加工状况可在控制画面上同步显示。操作人员通过触摸控制画面上的图形化按钮，就可以简单地完成操作，使得设备操作和维修保养都变得非常容易。



操作画面



工作条件显示画面

Specifications

Specification	Unit	DFP8140	DFP8160	
Wafer Diameter	mm	φ 4"/5"/6"/8" Select one size	φ 200/φ 300 Select one size	
Polishing Method	-	Anomalous In-feed grinding with wafer rotation		
Dry Polishing Wheel	mm	φ 300	φ 450	
Chuck table type	-	Porous chuck table		
Chuck-method	-	Vacuum		
Number of	min ⁻¹	0 - 300		
Chuck table cleaning	-	Water & air thrust up, Leveling stone and brush cleaning		
Spindle	Output	kW	4.8	7.5
	Revolution	min ⁻¹	1,000 - 4,000	1,000 - 3,000
Internal load sensor	-	Thin force sensor		
Spinner unit	-	2-stream jet nozzle cleaning & both side drying		
Machine dimensions(WxDxH)	mm	1,200×2,670×1,800	1,400×3,322×1,800	
Machine weight	kg	Approx.1,900	Approx.2,400	

■使用条件

- 请使用大气压露点在-15℃以下，残余油分为0.1 ppm，过滤度在0.01 μm/99.5%以上的清洁压缩空气。
- 请将放置机械设备的房间室温设定在20℃~25℃之间，并将波动范围控制在±1℃以内。
- 请将研磨水的水温控制为室温+2℃（波动范围：1小时在1℃以内），将冷却水的水温控制为20℃~25℃（波动范围：1小时在2℃以内）。
- 其它，请避免设备受到撞击及外界的可感振动。另外，请不要将设备安装在鼓风机、通风口、产生高温的装置及产生油雾的装置附近。
- 本设备会使用水。万一发生漏水影响，请把本设备安装在有防水性之地板及有排水处理之场所。
- ※ 为了改进设备，本公司可能在预先不通知用户的情况下，就对本规格实施变更，因此请仔细确认规格后发出订单。
- ※ 压力全部使用压力表指示压力值表示。
- ※ 关于本设备的应用技术等咨询，请与本公司销售部门联络。